

中部TLO 保有特許情報(分野別一般紹介分)

Ref.	出願番号	出願日	発明の名称	発明の簡単な説明
A-130	特願2007-276652 特開2008-72136	H19.10.24	半導体放射線検出器の製造方法	半導体を用いた放射線検出器の製造技術。利用分野は医療用レントゲン検査装置、X線非破壊検査装置などで、Si基板上に直接CdTe等の厚膜を成長させる事により安価な大面積放射線検出器が製造可能な画期的な技術。
A-173	特願2006-239164 特開2008-64463	H18.9.4	β-γ照射による軟質材料の構造解析方法及びその軟質材料保持装置	生体組織等の軟質材料が、液体と反応して微小変化をする場合の時間的変化を、X線、赤外線等のβ-γ照射により取付けたまま観察を可能にする材料の保持装置。
E-37	特願2007-220131 特開2008-7440	H18.6.28	前駆脂肪細胞分化誘導促進剤及び飲食物	キササゲ(植物)から抽出した新規な前駆脂肪細胞分化促進剤。前駆脂肪細胞の脂肪細胞への分化促進作用より、血中グルコースの脂肪細胞による取り込み活性が促進され、血糖低下作用に繋がる。糖尿病の予防及び改善剤(医薬品)として、またキササゲの抽出成分を飲食物として応用可能。
A-168A	特開2007-217398	H19.1.15	緩下剤(かんげざい)及びこれを含む食品	沈香葉から抽出した、穏やかな下剤としての作用を有する緩下剤。副作用の下痢が少ないため、常用により便秘の予防、改善を円滑に行うことができる。医療用、サプリメントの他、健康茶としての飲用にも応用可能。
A-163	特願2005-258866 特開2007-70284	H17.9.7	抗糖尿病合併症剤	糖尿病合併症(糖尿病性腎症、糖尿病性白内障)の治療剤として有用である生理活性物質。ラットを用いた実験により有効性を証明した。糖尿病合併症の治療薬として用いることができるほか、食品添加物としての利用も可能である。
A-161	特願2005-164094 特開2006-335712	H17.6.3	トリアリールアミンの製造方法	白金族系の触媒を用い、高収率でトリアリールアミンを合成する方法。ウルマン型反応と違い、比較的低温度できれいに反応が進むため不純物の生成が少ない。触媒の再利用による収率低下も見られず非常に実用的なトリアリールアミンの合成方法。
A-159	特願2005-018193 特開2006-206467	H17.1.26	メラニン産生不全症治療剤	メラニン産生促進作用により白毛症を予防、改善する新規な治療剤。副作用が少ないので、安全性に優れ、医薬部外品(化粧品など)として利用できる。
A-158	特願2004-343155 特開2006-151853	H16.11.26	カルボニル化合物の製造方法及び芳香族カルボン酸の製造方法	アルコール又は芳香族アルカンより光酸化によりカルボン酸或いはケトン類を製造する方法。常温光酸化反応であり、重金属、硝酸等を用いない為環境負荷が少なく得られる目的物の収率も高い。
A-156	特願2004-315994 特開2006-122971	H16.10.29	鋳鉄の鋳造方法	鋳鉄を部品形状をした鋳型に半凝固状に鋳込み、ただちに低圧に加圧しながら凝固させることにより、表面硬度(強度)と靱性に優れた鋳造部品の製造方法を提供する。
A-150	特願2004-195902 特開2006-15255	H16.7.1	不斉アシル化触媒及び光学分割方法	医農薬、食品化学等の重要な中間体である光学活性アルコールを効率よく作る方法。ラセミの2級アルコールを酵素によらずに、高選択的に光学分割を可能とするシンプルな構造の触媒。
A-148 (G-62)	PCT/JP2005/005628 WO 2005/114182	H16.5.20	ヒスタミン検出方法およびヒスタミン検出キット	HACCP規制に対応可能なアレルギー様中毒の原因物質であるヒスタミンを極めて簡便に低コストで処理可能な新規検出方法。魚介類とその加工品、みそ・醤油等発酵食品のヒスタミン含量チェックの検出キットとして利用可能。

A-139 (G-56)	PCT/JP2005/004259 WO 2005/08578	H16.3.9	光学式触覚センサを利用したセンシングシステム及びロボットハンド	半球形状の透明弾性体とCCDカメラからなる光学式の触覚センサを特徴とする。ロボットハンドに搭載することによって摩擦係数未知の対象物を安定に把持できる可能性がある。
A-133	特願2004-048900 特開2005-239594	H16.2.25	脂肪族アミンのアルキル化方法	脂肪族アミンのモノアルキル化、ジアルキル化を選択的にそれぞれを高収率で合成する方法。特にモノアルキル体を選択的に安価に合成する方法は従来になく、画期的な技術である。
A-130 (G-52)	PCT/JP2004/017891 WO 2005/053038	H15.11.27	半導体放射線検出器の製造方法	半導体を用いた放射線検出器の製造技術。利用分野は医療用レントゲン検査装置、X線非破壊検査装置などで、Si基板上に直接CdTe等の厚膜を成長させる事により安価な大面積放射線検出器が製造可能な画期的な技術。
A-129A	特願2004-80917 特開2005-154402	H16.3.19	金属錯体タンパク質複合体及び酸化触媒	有機溶媒に比して環境面で有利な、水系での常温酸化反応触媒として機能し、水溶性基質の不斉酸化に応用できる、金属錯体をタンパク質キャビティに挿入した複合体。触媒の回収、触媒劣化保護にも有利かつ固定化可能。
A-127 (G-44)	10/790,060 US-2005-0049405-A1	H15.9.2	金属錯体タンパク質複合体及び水素化触媒	有機溶媒に比して環境面で有利な、水中での水素化反応触媒として機能し、水溶性基質の水素化に応用できる、金属錯体をタンパク質キャビティに挿入した複合体。触媒の回収、触媒劣化保護にも有利。
A-125	特願2003-208536 特開2005-66384	H15.8.25	濾過方法及びその装置	懸濁液の粒子を実質的に分散状態に維持し、懸濁液の濾過あるいは濃縮を簡素な機構で連続処理を可能とする装置。
A-124	特願2003-295713 特開 2005-061585	H15.8.19	非接触式案内装置	液体が持つ表面張力により摺動面と案内面の間に液体を封じ込め、両面を非接触状態に維持し、両面の距離変化に抗するため可動体が案内面に垂直に拘束され、低摩擦な軸受け等の案内装置。
A-122 (G-50)	PCT/JP2004/010998 WO 2005/012536	H15.7.31	増殖制御型組替えアデノウイルスベクターの効率的な作製方法及びその作成用キット	癌細胞を多因子で特異標的化する増殖型アデノウイルスベクターの迅速かつ簡便な作製法。従来の非増殖型ウイルスベクターに比べ遺伝子導入効率が優れ、癌への遺伝子治療に有用である。
A-110	特願2003-128798 特開2004-331790	H15.5.7	無機-有機ハイブリッド材料及びその製造方法	機械的強度、弾性率、耐熱性等の物性の向上を目的とした、アクリル系ポリマー(MMAなど)とケイ酸とが共有結合によって複合された有機-無機ハイブリッド材料とその製造方法。
A-71A (G-26)	PCT/JP03/05020 WO 03/090368	H15.4.18	イメージ信号キャンセル型ヘテロダイン受信方式およびダイレクトコンバージョン直交周波数分割多重受信方式	(PCT出願に併せて国内優先権主張を実施) 携帯電話等の受信回路において、小型化のためSAWフィルタを省略した低IF方式を用いる場合、ノイズとなるイメージ信号を効率的にキャンセルする方法。
A-51	特願2001-299260 特開2003-104897	H13.9.28	病原性細菌の増殖抑制方法	病原大腸菌O-157の増殖を効率よく抑制する組成物である。食品、調理器具、医療器具等の汚染防止に利用できる。
A-50	特願2001-299219 特開2003-107241	H13.9.28	多層反射膜	GaNとAlGaN等物性定数の違いにより割れを生じやすい材料を用いてファブリーペロー型多層反射膜を形成する場合において、材料の割れを防いで高反射率の多層反射膜を作成する方法。超高輝度発光ダイオードや面発光レーザに適用可能。

A-49	特願2001-292052 特開2003-101069	H13.9.25	族窒化物量子ドットの製造方法	GaNの量子ドットを1cm ² 当たり10の12乗個以上の分布密度で作成する方法。超高輝度発光ダイオードや面発光レーザーの作成が可能。
A-48	特願2001-285733 特開2003-91236	H13.9.19	楕円曲線スカラー倍点演算装置	公開鍵を用いる楕円曲線暗号の暗号化・復号化に必要なスカラー倍点演算を高速化する方法。従来比30%以上の高速化が可能。
A-47	特願2001-272197 特開2003-87111	H13.9.7	高速論理回路	N型負性抵抗素子を用いた1THz動作が可能な高速論理ゲートと、この論理ゲートを組み合わせた論理回路。A-29のモジュレータと組み合わせて超高速A/D変換器を構成できる。
A-46	特願2001-270876 特開2003-75378	H13.9.6	2次イオン分析装置	イオン照射により固体表面から放出される2次イオンの角度分布が簡単に測定できる分析装置。角度分布の測定により極表面層の成分分布を測定できるほか、分析精度の向上が期待できる。種々の組成の薄膜やサイズを制御したクラスター薄膜の作成にも応用可能。
A-40	特願2001-242334 特開2003-52391	H13.8.9	淋菌の検出及びニューキノロン剤の感受性評価方法	淋菌遺伝子の配列の変異をリアルタイムPCR法を用いて測定し、淋菌の存在と、そのキノロン剤感受性を評価する方法。従来法に比べ、臨的に多数の検体を迅速に処理可能。
A-38	特願2001-230826 特開2003-45852	H13.7.31	族窒化物半導体のドライエッチング方法	族窒化物半導体、特にGaNのドライエッチングにおけるエッチピットの発生を防止し、平滑なエッチング面を得る方法。
A-56	特願2001-359765 特開2002-333421	H13.11.26	カルボン酸センサ	カルボン酸(特にクエン酸)に強く応答するポルフィリン錯体を用いてイオン感応膜を形成し、カルボン酸濃度を測定するセンサ。果汁やワインの酸度測定を現場で行なえる。(A-28優先権主張)
A-34	特願2001-105116 特開2002-300876	H13.4.3	組織形成細胞内で外来遺伝子を発現させる方法	外来遺伝子をエレクトロポレーションを用いて組織形成細胞内に導入し、高い効率で発現させる方法。(DNAを導入する場合に比較して約120倍高い)従って再生医療分野における培養組織などの機能改変の一手段として使用できる。
A-33	特願2001-096940 特開2002-296230	H13.3.29	電気化学式炭酸ガスセンサ	基準ガスや固体標準物質を必要とせず、通常大気中の炭酸ガス濃度を高精度に連続測定でき、人の入室も検出できる炭酸ガスセンサ。
A-25	特願2001-058224 特開2002-257993	H13.3.2	中性子源	トカマクプラズマ装置内に設置した局所電極により強い径電場を形成し、重水素イオンを加速・収束して高い濃度の中性子を発生させる装置。中性子測定器の校正や同位元素製造装置に使用できる。
A-12	特願2000-373765 特開2002-175306	H12.12.8	遺伝子のクラスタリング方法	DNAチップを用いて遺伝子の発現状態をモニタリングし、その発現シグナルパターンから遺伝子を高精度にクラスタリング(グループ化)する。
A-09	特願2000-338023 特開2002-150291	H12.11.6	動点軌跡計測方法	人間の皮膚のような低テクスチャ画像のオプティカルフローを求める方法。動画映像から関節の動きの異常検出や顔の表情変化の計測に利用できる。

A-07	特願2000-318826 特開2002-129208	H12.10.19	微細結晶材料の製造方法	微細結晶材料を製造する際の機械的合金化処理に要する時間がほぼ1/4になる。
A-06	特願2000-306321 特開2002-118494	H12.10.5	多信号の送受信方式	受信機側に最小の負荷(信号処理回路)を付加するだけで既存のCDMA等の送受信システムで処理できる信号数を増加させる。雑音のフィルタリングとしても利用できる。
A-05	特願2000-289118 特開2002-103145	H12.9.22	創成放電加工機	パイプ電極の先端面と被加工物との間の放電ギャップをリアルタイムで測定し、常に最適な放電ギャップで加工できる創成放電加工機。
A-03	特願2000-272163 特開2002-088094	H12.9.7	生理活性物質基含有化合物	抗生物質や抗菌物質等に重合性を付与し、生理活性を持つ高分子化合物を造る基本技術。
A-02	特願2000-250122 特開2002-064096	H12.8.21	半導体装置及びその製造方法	MOStランジスタのゲート薄膜化によるリーク電流を減らすことができる、高い比誘電率をもった窒化膜の製造方法。
A-71A (G-26)	PCT/JP03/05020 WO 03/090368	H15.4.18	イメージ信号キャンセル型ヘテロダイ 受信方式およびダイレクトコンバージ ョン直交周波数分割多重受信方式	(PCT出願に併せて国内優先権主張を実施) 携帯電話等の受信回路において、小型化のためSAWフィルタを省略した低IF方式を用いる場合、ノイズとなるイメージ信号を効率的にキャンセルする方法。
A-42 (G-13)	PCT/JP02/08394 WO 03/019681	H13.8.23	熱電変換材料	ホイスラー型の結晶構造を持つ、熱間圧延可能なFe ₂ MAI系熱電変換材料。半導体であるBi ₂ Te ₃ 系に比べ、室温以下での電気抵抗が小さいため出力係数大きい。また成分は安価な材料であり、有害元素を含まない。
A-39	PCT/JP02/07748	H13.8.1	族窒化物半導体膜の製造方法	族窒化物半導体にナノスケールの柱状構造を生成し、その上に半導体膜を成長させることにより格子欠陥の非常に少ない半導体膜を作成する方法
A-27 A-26 (G-06)	PCT/JP02/00579 WO 02/071142	H13.3.2	広帯域光スペクトル発生装置	(企業とオプション契約締結済)